

2SA907, 2SA908, 2SA909

■シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ

☆ 2 SC1584～2 SC1586とコンプリメンタリペアになります。

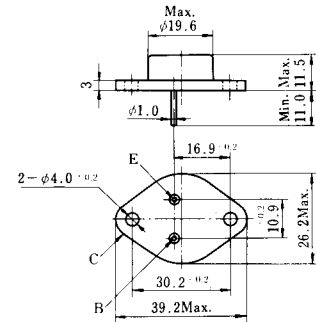
○一般用

○通信産業用

■最大定格 (Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 2SA907 | 2SA908 | 2SA909 |
|-------------|------------------|--------------------|--------|--------|
| コレクタ・ベース電圧 | V _{CB0} | -100V | -150V | -200V |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CEO} | -100V | -150V | -200V |
| エミッタ・ベース電圧 | V _{EBO} | -6V | | |
| コレクタ電流 | I _C | -15A | | |
| ベース電流 | I _B | -5A | | |
| 許容コレクタ損失 | P _C | 150 W (フランジ温度25°C) | | |
| 接合部温度 | T _J | 150°C | | |
| 保存温度 | T _{stg} | -65～+150°C | | |

外形寸法 (単位: mm)
JEDEC (TO-3), EIAJ TC-3, TB-3



■電気的特性 (Ta=25°C)

| 項目 | 記号 | 試験条件 | 2SA907 | 2SA908 | 2SA909 |
|-------------|----------------------|---|-------------|---------|---------|
| 最大コレクタシャ断電流 | I _{CBO} | | -1.0 mA | -1.0 mA | -1.0 mA |
| | | V _{CB} = | -100 V | -150 V | -200 V |
| 最大エミッタシャ断電流 | I _{EBO} | V _{EB} = -6V | -1.0 mA | | |
| コレクタ・エミッタ電圧 | V _{CEO} | I _C = -50mA | -100 V | -150 V | -200 V |
| 直流電流増幅率 | h _{FE} | V _{CE} = -4V I _C = -5A | 30 Min. | | |
| コレクタ飽和電圧 | V _{CE(sat)} | I _C = -10A I _B = -1A | -3V Max. | | |
| シャ断周波数 | f _T | V _{CE} = -12V I _E = 0.5A | 10 MHz Typ. | | |

周囲温度と最大許容損失

